

請求の範囲

- [請求項1] Cr (クロム)、シリコン (Si) を含む Cr-Si 系焼結体であり、X線回折で帰属される結晶構造がクロムシリサイド (CrSi_2)、シリコン (Si) から構成され、 CrSi_2 相がバルク中に 60 wt % 以上存在し、焼結体密度が 95 % 以上であり、 CrSi_2 相の平均粒径が $60\ \mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする Cr-Si 系焼結体。
- [請求項2] 抗折強度が 100 MPa 以上であることを特徴とする請求項1に記載の Cr-Si 系焼結体。
- [請求項3] バルク中の酸素量が 1 wt % 以下であることを特徴とする請求項1又は2に記載の Cr-Si 系焼結体。
- [請求項4] 請求項1～3のいずれかに記載の Cr-Si 系焼結体からなることを特徴とするスパッタリングターゲット。
- [請求項5] 請求項4に記載のスパッタリングターゲットを用いてスパッタリングすることを特徴とする薄膜の製造方法。